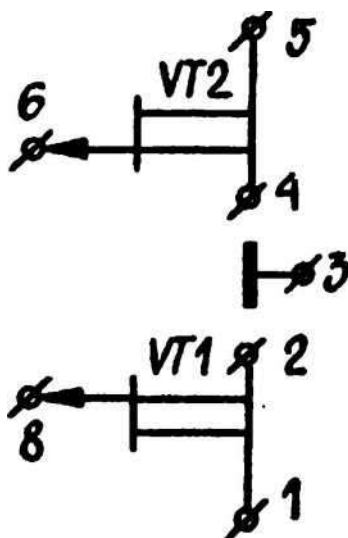


К504НТ1А — К504НТ1В, К504НТ2А — К504НТ2В, КР504НТ1А — КР504НТ1В, КР504НТ2А — КР504НТ2В

Микросхемы представляют собой слаботочную согласованную пару полевых транзисторов, предназначенных для применения во входных каскадах усилителей постоянного тока, в дифференциальных и операционных усилителях и коммутаторах. Корпус типа 301.8-2, масса не более 1,5 г и типа 201.8-1, масса не более 1,8 г.



Электрическая схема К504НТ1, КР504НТ1, К504НТ2, КР504НТ2

Назначение выводов: 1 — сток VT1; 2 — исток VT1; 3 — корпус; 4 — исток VT2; 5 — сток VT2; 6 — затвор VT2; 8 — затвор VT1.

Электрические параметры

Напряжение отсечки.....	≤ 5 В
Разность напряжений затвор — исток К504НТ1, КР504НТ1	≤ 30 мВ
Начальный ток стока:	
К504НТ1А, КР504НТ1А, К504НТ2А, КР504НТ2А.....	0,1... 0,7 мА
К504НТ1Б, КР504НТ1Б, К504НТ2Б, КР504НТ2Б.....	0,4... 1,5 мА
К504НТ1В, КР504НТ1В, К504НТ2В, КР504НТ2В.....	0,7... 2 мА
Ток утечки затвора	≤ 2 нА

Крутизна характеристики:

**К504НТ1А, КР504НТ1А, К504НТ2А,
КР504НТ2А $\geq 0,3$ мА/В**

**К504НТ1Б, КР504НТ1Б, К504НТ2Б,
КР504НТ2Б..... $\geq 0,5$ мА/В**

**К504НТ1В, КР504НТ1В, К504НТ2В,
КР504НТ2В..... $\geq 0,7$ мА/В**

Коэффициент шума при $R_f = 1$ МОм, $f = 1$ кГц ≤ 4 дБ

**Отношение значений крутизны характеристики
транзисторов в паре К504НТ2, КР504НТ2 $\geq 0,85$**

Температурный дрейф напряжения смещения:

К504НТ1, КР504НТ1 ≤ 50 мкВ/°С

К504НТ2, КР504НТ2 ≤ 250 мкВ/°С

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение затвор — сток 10 В

Прямое напряжение затвор — исток $\geq -0,2$ В

Температура окружающей среды $-45...+ 85$ °С